

Расписание на 30 июня

для «Общего зала»

Начало	ФИО	Название доклада	Секция
9:00		Регистрация участников	
10:00	Теруков Евгений Иванович	Открытие конференции Председатель Оргкомитета	
10:15	Козюхин Сергей Александрович	Лазерная модификация фазопеременных материалов	Коломийцевская лекция
10:50	Кофе-брейк		
11:20	Представитель РНФ	Представитель РНФ	Школа
11:50	Бражкин Вадим Вениаминович	Халькогенидные стекла и высокие давления: фазовые превращения, необратимость и релаксация	А
12:10	Колобов Александр Владимирович	Amorphous chalcogenides: from passive optical elements to neuromorphic applications	А
12:30	Ковалюк Вадим Викторович	Фотонные интегральные схемы для вычислений, коммуникаций и сенсоров	Школа
13:00	Обед		
14:00	Yan Cheng	Structure transition in typical chalcogenide compounds (онлайн)	В
14:20	Дронов Алексей Алексеевич	Технологические основы получения функциональных наноструктур с управляемыми характеристиками	В
14:40	Дубков Сергей Владимирович	Development of technologies for fabrication of SERS-active nanostructures for biosensorics	В
15:00	Мухин Иван Сергеевич	Эпитаксиальные слои GaP на сапфире с малыми оптическими потерями для фотонных интегральных схем	Школа
15:30	Кофе-брейк		
16:00	Шамрай Александр Валерьевич	Интегральная фотоника на основе ниобата лития – это сверхширокополосная модуляция и ультравысокие скорости управления оптическими сигналами	Школа
16:30	Гаврилин Илья Михайлович	Наноструктурированные материалы на основе германия для устройств накопления и преобразования энергии	В

16:50	Ануфриев Юрий Владимирович	Методы получения и автоэмиссионные свойства углеродных наноструктурированных материалов: углеродные нанотрубки, углеродные наностенки и структурированный карбид кремния	В
17:05	Конференционный фуршет		

Расписание на 1 июля
для «Общего зала»

Начало	ФИО	Название доклада	Секция
10:00	Кудряшов Сергей Иванович	Фундаментальные эффекты взаимодействия кристаллического кремния с ультракороткими лазерными импульсами и применения в нанофотонике	Школа
10:30	Троян Евгений	Формирование кристаллической фазы в халькогенидных полупроводниках нового поколения	А
10:45	Терехов Дмитрий Юрьевич	Фазопеременные материалы для создания термоэлектрических генераторов	А
11:00	Кофе-брейк		
11:30	Шулейко Дмитрий Валерьевич	Laser-induced modification of chalcogenide vitreous semiconductor films: periodic surface nanorelief, optical anisotropy and photoluminescence	А
11:45	Толкач Никита Михайлович	Оптимизация спектральных зависимостей отражения и пропускания многослойных структур на основе материалов системы Ge-Sb-Te от степени кристалличности	А
12:00	Мухаметкаримов Ержан Советбекович,	Кинетика кристаллизации тонких пленок аморфного селенида индия (онлайн)	А
12:15	Фотиади Андрей Александрович	Волоконные лазеры с низким уровнем шума и их потенциальные применения	Школа
12:45	Обед		
13:45	Тверьянович Юрий Станиславович	Стеклообразные неорганические полупроводники с повышенной пластичностью	А
14:05	Лазаренко Петр Иванович	Фазопеременные материалы: особенности получения, исследования и применения	А
14:25	Лотин Андрей Анатольевич	Особенности изменения свойств тонких пленок и наночастиц фазоизменяемых материалов	А

14:45	Приходько Олег Юрьевич	Структура и свойства пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$, модифицированных азотом (онлайн)	A
15:00	Кофе-брейк		
15:30	Смаев Михаил Петрович	Modification of thin $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ films with light beams of different spatial structure and their application for control of laser radiation parameters	A
15:50	Пестова Виктория Борисовна	Перестраиваемые отражающие оптические элементы на основе тонких пленок фазопеременного материала $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ для устройств энергонезависимого отображения информации	A
16:05	Леньшин Александр Сергеевич	Исследование свойств и структуры наночастиц пористого кремния с осажденным циннаризином	B
16:20	Zhang Baode	The charge separation of PIDT-BT/Single walled carbon nanotube quantum Heterojunctions	B
16:45	ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ		

Расписание на 1 июля
для «Второго зала»

Начало	ФИО	Название доклада	Секция
10:00	Андрианов Александр Васильевич	Возбуждение терагерцового излучения ультракороткими лазерными импульсами в p-n-гетероструктурах аморфный кремний/кристаллический кремний	C
10:20	Ковалев Михаил Сергеевич	Быстродействующие фотодиоды Шоттки на легированном аморфном кремнии для телекоммуникационных длин волн	C
10:40	Косарев Андрей Иванович	Тонкопленочные ИК и ТГц сенсоры на основе пленок, получаемых в плазме газового разряда	C
11:00	Кофе-брейк		
11:30	Устинов Алексей Борисович	Оптоэлектронные СВЧ генераторы	Школа
12:00	Аболмасов Сергей Николаевич	Interdigitated back contact silicon heterojunction solar cells: towards industrially feasible manufacturing methods	C

12:15	Павлов Сергей Игоревич	Резонансная фотоника метаповерхностей на основе гидрогенизированных аморфных полупроводников	C
12:30	Неверовская Анна Юрьевна	Модификация малослойного графена с целью получения устойчивой дисперсии	C
12:45	Обед		
13:45	Драчев Владимир Прокопьевич	Быстрое прототипирование фотонных интегральных схем на кремнии	Школа
14:15	Тамеев Алексей Раисович	Галогенидные перовскиты для детектирования рентгеновского излучения	D
14:35	Алешин Андрей Николаевич	Влияние модификации металлоорганических перовскитов углеродными наноструктурами на их фотоэлектрические свойства и временную стабильность	D
14:50	Текишина Екатерина Владимировна	Стабильность солнечных элементов, сенсibilизированных красителями на основе тиено[3,2-b]индола и их модификация	D
15:05	Кофе-брейк		
15:30	Гец Дмитрий Станиславович	Charge-carrier dynamics in CsPbBr ₃ perovskites	D
15:50	Саранин Данила Сергеевич	Up-scaling and prototyping of perovskite solar panels	D
16:10	Степарук Александр Сергеевич	Молекулярный дизайн и синтез органических красителей со структурой D-π-A и A-π-D-π-A для их применения в сенсibilизированных красителем солнечных элементах	D
16:30	Сон Александра Григорьевна	Исследование корреляций состав-структура-оптические свойства в наночастицах Cs-Pb-Br	D
16:45	ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ		

Расписание на 2 июля
для «Общего зала»

Начало	ФИО	Название доклада	Секция
10:00	Синев Иван	Материалы с фазовой памятью в фотонике (онлайн)	Школа

10:30	Рыбин Михаил Валерьевич	GeSbTe in photonics: fundamentals and applications	Е
10:50	Кицюк Евгений Павлович	Влияние типа и структуры катализатора на характеристики синтезируемых МУНТ	Е
11:10	Налимова Светлана Сергеевна	Атомно-молекулярный дизайн и наноархитектоника новых функциональных материалов	Е
11:30	Кофе-брейк		
12:00	Гудовских Александр Сергеевич	Формирование сверхрешеток InP/GaN на Si с помощью комбинации плазмохимического и атомнослоевого осаждения	Е
12:15	Паняев Иван Сергеевич	Развитие средств Brillouin-волоконной оптики для тестирования халькогенидных материалов	Е
12:30	Артемов Дмитрий Евгеньевич	Компоненты на основе ФИС для высокоскоростных ВОЛС	Школа
13:00	Обед		
14:00	Камынин Владимир Александрович	Гибридные источники нано- и пикосекундных импульсов с управляемой временной структурой	Школа
14:30	Трактирщиков Виктор Сергеевич	Разработка и применение электростатического крепежного устройства для технологического микроэлектронного оборудования	Е
14:50	Utegulov Zhandos	Phonon-mediated nanoscale thermal transport in phase-transformed and irradiated wide band-gap semiconductors	Е
15:10	Заботнов Станислав Васильевич	Femtosecond laser fabrication of anisotropic structures in thin amorphous films of silicon and GST225	Е
15:30	Кудряшов Сергей Иванович	Экспериментальные и теоретические исследования лазерного сверхлегирования аморфного и кристаллического кремния примесью золота	Е
15:50	Тарванен Дмитрий Александрович	Технологическое оборудование для микрообработки материалов и интегральной фотоники	Е
16:05	Гурьев Денис Аркадьевич	Полностью волоконные элементы многоуровневой оптической памяти на основе тонких пленок GST225	Е
16:20	Кофе-брейк		
17:00	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ		

Расписание на 2 июля
для «Второго зала»

Начало	ФИО	Название доклада	Секция
10:00	Теруков Евгений Иванович	Разработка промышленной технологии дешевых и эффективных солнечных батарей для космических аппаратов ближнего Космоса	G
10:20	Синельник Артем Дмитриевич	Мета-оптические системы на основе GeSbTe	G
10:40	Невзоров Алексей Алексеевич	Фазопеременные халькогенидные полупроводники в устройствах интегральной фотоники	G
11:00	Пономарев Роман Сергеевич	Сборка фотонных интегральных схем: оптимальные стратегии ввода-вывода излучения	Школа
11:30	Кофе-брейк		
12:00	Бобыль Александр Васильевич	Ренгенодифракционные и реальные размеры анизотропных кристаллитов с аморфным защитным слоем на примере LiFePO_4	G
12:15	Проходцов Алексей Игоревич	Исследования динамики переключения состояний интегральных фотонных устройств с перестраиваемыми элементами на основе фазопеременных халькогенидов	G
12:30	Толкач Никита Михайлович	Современное зондово-оптическое промышленное и научное оборудование для исследований аморфных и микрокристаллических полупроводниковых материалов	G
12:45	Бурцев Антон Андреевич	Устройства на основе наночастиц и нанокластеров халькогенидных фазоизменяемых материалов	G
13:00	Обед		
14:00	Шерченков Алексей Анатольевич	Среднетемпературные термоэлектрические материалы на основе PbTe. Стратегия повышения эффективности	G
14:20	Литвинов Владимир Георгиевич	Электрофизические свойства облученных протонами и электронами кремниевых гетероструктурных фотоэлектрических преобразователей	G
14:40	Травкин Владислав Владимирович	Фотопреобразователи на основе этиопорфиринаата дифторида кремния	G
14:55	Шарков Михаил Дмитриевич	МУРР-исследования порошков фосфата лития-железа с применением методики искусственных нейронных сетей	E

15:10	Мазинов Алим- Сеит Аметович	Токовые зависимости жидких и твердотельных пленочных структур комплексов $CuI-PPh_3$	E
15:25	Черкунов Виктор Игоревич	Решение для магнетронного напыления тонких плёнок оксида кремния и углерода	E
15:40	Утамурадова Шарифа Бекмурадовна	Рамановская спектроскопия дефектов в $n-Si$ с примесями хрома и эрбия	E
15:55	Киселев Алексей Владимирович	Se-содержащие фазопеременные материалы с низкими оптическими потерями для приложений инфракрасной фотоники	E
16:10	Барков Константин Александрович	Идентификация метастабильной фазы Ag_2Si в пленках $Ag-Si$ методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии	E
16:25	Кофе-брейк		
17:00	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ		

Расписание на 3 июля

10:00	Экскурсии по высокотехнологичным предприятиям и лабораториям, расположенным в г. Санкт-Петербурге
-------	---

ПОСТЕР СЕССИЯ

1	Alekberov R.I.	Photoinduced effects in the Ga-Sb-S chalcogenide glassy system
2	Alekberov R.I.	Application of models bond strength–coordination number fluctuation and scaled viscosity models to glass transition processes in the Sb-Se system
3	Dalal Avijit	Optimized 3-step thermal evaporation of Cs ₂ AgBiBr ₆ thin films for optoelectronic applications
4	Mekhtiyeva S.I.	Analysis of optical absorption in Ge-As-Se, Ge-As-Se-S chalcogenide glass systems by Belehradsek functional dependence and Taus method
5	Абанин А.И.	Технология изготовления планарных фотонных интегральных схем с высокодобротными кольцевыми резонаторами из нитрида кремния
6	Александров А.Е.	Диодные структуры на основе перовскитов для регистрации рентгеновского излучения
7	Александрович А.Н.	Оптические и структурные свойства неупорядоченных пленок Ge ₁₅ Se ₈₅ , отожженных ниже T _g , после их продолжительного старения
8	Алиева В.	Аномальное поведение диэлектрического гистерезиса в TlInS ₂ сегнетоэлектрике-полупроводнике индуцированное примесями лантана
9	Алиева Т.	Электрические свойства монокристаллов твердого раствора Pb _{0.75} Sn _{0.25} Te с различными концентрациями катионных вакансий
10	Аманжолова Г.С.	Активация молекулярного кислорода, O,N-допированными углеродными точками
11	Атаева С.У.	Процесс стеклования и кристаллизации халькогенидного стеклообразного полупроводника Se ₉₅ Te ₅
12	Бадалова З.Т.	Оптические параметры магнитного полупроводника TlFeS ₂
13	Баранов А.И.	Исследование свойств слоев Ga ₂ O ₃ и Al ₂ O ₃ для пассивации подложек черного кремния
14	Болдырева П.В.	Цифровая интерактивная киберфизическая модель установки магнетронного распыления
15	Вениаминова Я.О.	Особенности диэлектрических спектров пленок диоксида ванадия, легированных серебром
16	Верещагина К.В.	Нанокристаллический материал на основе ортоферрита висмута с улучшенными магнитными и фотокаталитическими характеристики
17	Волощук И.А.	Исследование влияния нанопорошка оксидов меди на электрофизические характеристики композитных термоэлектрических материалов на основе Bi ₂ Te _{2.8} Se _{0.2} и Bi _{0.5} Sb _{1.5} Te ₃
18	Воробьев Ю.В.	Температурные зависимости темновой и фотопроводимости в системе Ge-Sb-Te
19	Гавриков А.А.	Теоретическое исследование свойств аморфных фаз Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ , приготовленных in silico при различных скоростях закалки

20	Гарибова С.Н.	Применение гауссовского приближения к данным рамановской спектроскопии тонких пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ »
21	Гарибова С.Н.	Modeling of the electron structure for $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ based on density functional theory
22	Гнеушев Д.А.	Исследование температурных зависимостей электрофизических и термических свойств тонких пленок $\text{Ag}_4\text{In}_3\text{Sb}_{67}\text{Te}_{26}$
23	Голубева Д.А.	Влияние методики пробоподготовки на результаты исследования термических свойств тонких пленок фазопеременных материалов
24	Гудков Ю.Д.	Измерительный комплекс для исследования переходных процессов в барьерных структурах на основе неупорядоченных полупроводников
25	Гусейнова А.С.	Структурная и оптическая характеристика нанокомпозитов ПЭВП/ HfO_2
26	Гусейнова А.С.	Влияние высоковольтного импульсного газового разряда на полимерных нанокомпозитов
27	Гущина В.А.	Влияние катионного состава на оптические характеристики перовскитных наночастиц $\text{APbBr}_x\text{I}_{3-x}$
28	Далиев Х.С.	Спектроскопия дефектной структуры приповерхностного слоя кремния, легированного редкоземельными элементами (Dy, Yb)
29	Дмитриев И.Ю.	Композиционная защитная инкапсуляция для гетероструктурных кремниевых фотопреобразователей
30	Дубов Е.А.	Электронные свойства пленок фталоцианина меди на подложке с высокой работой выхода, MoO_3
31	Евсейчик М.А.	Моделирование взаимодействия наноразмерных катализаторов с адсорбированными органическими молекулами
32	Евсейчик М.А.	Синтез и свойства гетеросистем $\text{TiO}_2\text{-Ag}$ на основе пористого Al_2O_3
33	Егорова А.В.	Разработка новых полупроводников на основе моно- и со-допированного перовскита LaInO_3
34	Зарудная А.А.	Влияние органических катионов на структуру и транспорт заряда в тонких плёнках CsSnI_3
35	Ибраев Н.Х.	Фотосенсибилизация полупроводниковых пленок посредством плазмон-усиленного переноса энергии между органическими красителями
36	Ильичева Е.А.	Гибридная органическая прослойка для перовскитных фотомодулей, изготовленных методом slot-die
37	Кахраманов С.Ш.	О роли резонансной связи в легированных кристаллах Bi_2Te_3
38	Ким К.Б.	Осаждение меди на пористом кремнии методом вакуумно-термического напыления
39	Когай В.Я.	Плазмонные резонансы в тонкопленочных структурах $\text{Cu/As}_2\text{Se}_3$
40	Комаров И.А.	Особенности локальной модификации пленок оксида графена лазерным излучением с импульсом микросекундной длины
41	Косов Д.В.	Сверхвысокочастотные свойства углеродных модификаций в полосе 2 – 4 ГГц

42	Крупанова Д.А.	Наноструктурированные фотоаноды TiO_2 для гибких сенсibilизированных солнечных элементов
43	Кущенко О.М.	Управление интенсивностью фотолюминесценции в гибридных структурах на основе галогенидных перовскитов и $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
44	Лебедева Я.С.	Selective etching of laser-crystallized thin films of phase-change materials
45	Литвинов Д.А.	Гребенки с орбитальным угловым моментом
46	Лучников А.О.	Стабилизация интерфейсов галогенидного перовскита созданием 2D/3D гетероструктуры на основе $\text{AVA}_2\text{FAPb}_2\text{I}_7$
47	Макарук К.С.	Влияние подложки на микроструктуру фоточувствительных элементов на основе сульфида свинца
48	Макарук К.С.	Особенности структуры фоточувствительных элементов на основе микрокристаллических халькогенидов свинца
49	Мамедова И.А.	Электронные свойства кристаллов CuInS_2 : расчёты из первых принципов и эллипсометрические измерения
50	Марголин И.Г.	Локальное легирование для создания полупроводникового рисунка в тонких кремниевых плёнках
51	Марченко А.В.	Локальное окружение атомов германия в аморфных пленках $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
52	Миронов Г.В.	Портативная фотолитографическая установка
53	Михалевский В.А.	Мемристивные структуры на основе фазоизменяемых материалов и оксидов переходных металлов
54	Морозов А.П.	Модификация интерфейсов перовскитных фотодиодов для рентгеновских систем визуализации непрямого преобразования
55	Нагиев Т.Г.	Исследование методом ДСК облученных нейтронами наночастиц Si_3N_4 при низкой температуре
56	Наджафов А.И.	Экспериментальные и теоретические исследования рамановских спектров кристаллов системы твёрдых растворов $\text{TlGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Te}_2$
57	Никитин С. Е.	Деградация инкапсулированных солнечных элементов при длительном изгибе
58	Парочкин А. В.	Интеграция сегнетоэлектрических пленок $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ с тонкопленочными полупроводниками для создания устройств гибкой электроники
59	Петрова В.И.	Получение и исследование тонких аморфных слоев органических красителей для использования в солнечных элементах
60	Прудченко К.К.	Влияние термоциклирования на параметры кремниевых гетеропереходных солнечных элементов
61	Рыбина Н.В.	Влияние лазерного облучения на рельеф и структуру пленок GST225
62	Сафонова А.А.	Влияние легирования алюминием на оптические свойства моноклинной фазы диоксида ванадия
63	Саяров И.Р.	Формирование поликристаллических пленок двойного галогенидного перовскита и их электрические свойства

64	Сень В.В.	Влияние параметров синтеза на свойства алмазных пленок, выращенных методом MW PECVD на полупроводниковых и диэлектрических подложках
65	Смирнов П.А.	Amorphization of Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ thin films by femtosecond single-pulse laser irradiation
66	Смирнова С.П.	Исследование эмиссионных параметров прототипа нового низковольтного катода
67	Совтус Н.В.	Закон Джоуля-Ленца для гиперболического уравнения теплопроводности в аморфном халькогенидном полупроводнике
68	Трусов Е.П.	Влияние отжига и естественного старения на электрические свойства фазопеременных материалов системы GeTe – Sb ₂ Te ₃
69	Утамурадова Ш.Б.	Влияния температуры на эксплуатационные характеристики HJT элементов в диапазоне 173 – 373 К
70	Федянина М.Е.	Исследование стабильности оптических свойств тонких пленок Ge ₂ Sb ₂ Te ₅
71	Фефелов С.А.	Прохождение импульса тока через структуру TiN/Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ /Au
72	Царева А.А.	Моделирование tandemных фотопреобразователей перовскит/кремний в программе SCAPS-1D
73	Черемисин А.В.	Изучение спектральных зависимостей фоточувствительности в эпитаксиальных структурах Au-окисел-n-GaAs _{0.6} P _{0.4} /n+-GaAs для экологических приложений
74	Шпеньков Г.П.	О проводимости графена
75	Щегольков А.В.	О возможности использования оксида графена в электрохромных пленках оксида вольфрама
76	Эль-Хадж Л.А.	Формирование топологического рисунка методами позитивной и негативной фотолитографии на портативной установке экспонирования
77	Якубов А.О.	Особенности технологии формирования тонких пленок халькогенидных фазопеременных материалов